

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
【部門区分】第 6 部門第 2 区分
【発行日】平成 17 年 4 月 7 日 (2005.4.7)

【公開番号】特開 2003-162051 (P2003-162051A)
【公開日】平成 15 年 6 月 6 日 (2003.6.6)
【出願番号】特願 2001-360938 (P2001-360938)
【国際特許分類第 7 版】
G 0 3 F 7/004
【F I】
G 0 3 F 7/004 5 0 3 A

【手続補正書】
【提出日】平成 16 年 5 月 25 日 (2004.5.25)
【手続補正 1】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】特許請求の範囲
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項 1】

(a) 電子線又は X 線の照射により酸を発生する化合物を含有する電子線又は X 線レジスト組成物において、

該電子線又は X 線の照射により酸を発生する化合物 (a) が、スルホニウムスルホン酸塩及びヨードニウムスルホン酸塩の群から選択されるオニウムスルホン酸塩を少なくとも 2 種含有することを特徴とする電子線又は X 線レジスト組成物。

【請求項 2】

請求項 1 に記載の電子線又は X 線レジスト組成物によりレジスト膜を形成し、当該レジスト膜を露光、現像することを特徴とするパターン形成方法。